

大阪大学 ナノテクノロジー設備供用拠点

微細加工プラットフォーム、分子・物質合成プラットフォーム 課金規程

(平成24年 12月13日制定 管理運営委員会)

(平成25年 4月 8日改定 管理運営委員会)

(平成26年 3月 1日改定 管理運営委員会)

(平成27年 3月31日改定 管理運営委員会)

(平成28年 3月 7日改定 管理運営委員会)

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学内に設置されたナノテクノロジー設備供用拠点（以下、「当拠点」という。）の利用において、大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点利用規程第12条の2にかかる利用負担金（微細加工プラットフォーム及び分子・物質合成プラットフォームの利用料、代行料、クリーンルーム入室料）を定めるものとする。

(利用料)

第2条 当拠点が設置供用する装置及び実験室等（以下、「装置群等」という。）のうち、利用規程別表に定める微細加工プラットフォーム管理の装置群等のうち別に定める区分に従って分類したもの（以下「加工A群」、「加工B群」および「加工C群」という。）、分子・物質合成プラットフォーム管理の装置群を使用することに伴う機器の利用料について、学内外の利用申込者（支援利用契約書第4条で定める「支援利用申込者」）は、当拠点の指定する方法により利用料を負担しなければならない。

2 成果公開区分の利用料の額は加工群、合成群の利用について、それぞれ別表1-1-1、別表1-1-2、別表1-1-3、別表1-2に定めるところによる。

3 自主および委託のうち成果非公開区分の利用料の額は第2項の各別表に定めた額の3倍額とする。

4 利用料の額は1の課題およびプラットフォームについて1の料金を適用する。

5 一旦納付された利用料は、返還しない。ただし、天災その他の不可抗力又は研究遂行上やむを得ない事由、あるいは利用申込者からの申し入れがあり利用申込者と本拠点との双方の合意がある場合は、協議の上、利用料の全部又は一部を返還する。

6 拠点長の判断により料金表の適用について別途指定することがある。

(代行料)

第3条 当拠点が設置供用する装置及び実験室等（以下、「装置群等」という。）のうち、利用規程別表に定める微細加工プラットフォーム管理の装置群および分子・物質合成プラットフォーム管理の装置群の技術代行（当拠点の支援員が当該課題の支援のため、装置の操作の作業ならびにその操作前後に行なう必要な作業であって、利用者に代わり行うもの。ただし、機器のメンテナンスにかかる部分を除く。）に対する代行料について、学内外の利用申込者（支援利用契約書第4条で定める「支援利用申込者」）は、当拠点の指定する方法により代行料を負担しなければならない。

- 2 成果公開区分の代行料の額は加工群、合成群について、それぞれ別表 2-1 および別表 2-2 に定めるところによる。
- 3 自主および委託のうち成果非公開区分の代行料の額は第 2 項に定めた額の 3 倍額とする。
- 4 前条第 4 項、第 5 項および第 6 項は代行料についても適用する。

(クリーンルーム入室料)

第 4 条 当拠点が設置供用するクリーンルーム(大阪大学産業科学研究所 I215 室および N415 室、以下同じ)を利用する利用申込者および共同利用者(支援利用申込書に記載の共同利用者であつてプラットフォーム利用のためにクリーンルームに入室する者、以下同じ)が入室するにあたり、クリーンルームの環境の整備・管理に要する費用の一部を負担するため、利用者は当拠点の指定する方法により、クリーンルーム入室料を負担しなければならない。

- 2 クリーンルーム入室料は別表 3 に定めるところによる。
- 3 第 2 条第 5 項および第 6 項はクリーンルーム入室料についても適用する。

附則

本料金表は平成 28 年 4 月 1 日以降の利用分について適用する。

別表 1-1-1 (加工 A 群利用料)

料金制	1 の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/4 時間)	単位	12,000	18,000
月極 (円/月) *1		120,000	180,000
年極 (円/年) *2		1,200,000	1,800,000

別表 1-1-2 (加工 B 群利用料)

料金制	1 の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/4 時間)	単位	8,000	12,000
月極 (円/月) *1		80,000	120,000
年極 (円/年) *2		800,000	1,200,000

別表 1-1-3 (加工 C 群利用料)

料金制	1 の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/4 時間)	単位	6,000	9,000
月極 (円/月) *1		60,000	90,000
年極 (円/年) *2		600,000	900,000

別表 1-2 (合成群利用料)

料金制	1 の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/4 時間)	単位	4,500	6,000
月極 (円/月) *1		27,000	36,000
年極 (円/年) *2		270,000	360,000

別表 2-1 (加工群代行料)

料金制	1の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/1時間)	工数	2,000	3,000

技術代行で利用する場合において、別表 1-1-1、別表 1-1-2、別表 1-1-3 に定める額とは別途課す。

別表 2-2 (合成群代行料)

料金制	1の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
従量制 (円/1時間)	工数	2,000	3,000

技術代行で利用する場合において、別表 1-2 に定める額とは別途課す。

別表 3 (クリーンルーム入室料)

	1の呼称	大学・公的研究機関	民間企業等
大阪大学産業科学研究所 I215 室または N415 室の 1 カ月 1 回以上の入室 (円/名、月額) *3	点	1,000	1,000

- ・別表 1-1-1、別表 1-1-2、別表 1-1-3、別表 1-2 については別表毎に料金制を選択できる。
- ・従量制において 1 カ月の課金額は月極額を上限とする。従量制および月極の一年度内の課金額は年極額を上限とする (別表 2-1、別表 2-2 を除く)。

*1: 月の初回利用前に申告した場合に適用。支援開始月に支援終了月までの利用料を納付する。ただし、利用者からの要望があれば 4 半期毎の納付も可能である。

*2: 年度の初回利用前に申告した場合に適用。支援開始月に利用料を納付する。

*3: 申込課題にかかる利用のために大阪大学産業科学研究所 I215 室または N415 室を 1 カ月に 1 回以上入室する利用申込者および共同利用者 1 名毎に課す。1 カ月以内に同一人が両方に入室しても重複して課さない。利用申込者が同時に複数にわたる課題で利用する場合においては、そのうちの最も申込日が早い課題に対してのみ課す。

第 2 条の 1 関連「別に定める区分」表

微細加工プラットフォーム支援提供装置 A 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FA-01	高精細集束イオンビーム装置	ZEISS “ORION NanoFab”
FA-02	多元 DC/RF スパッタ装置	キャノンアネルバ “EB1100”

微細加工プラットフォーム支援提供装置 B 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FB-03	超高精細電子ビームリソグラフィ装置	エリオニクス “ELS-100T”
FB-04	集束イオンビーム誘起化学蒸着装置	ZEISS “Nvision 40D with NPVE”
FB-05	深掘りエッチング装置	サムコ “RIE-400iPB-NP”
FB-06	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR-NP”
FB-07	RF スパッタ成膜装置:金属成膜用	サンヨー電子 “SVC-700LRF”
FB-08	RF スパッタ成膜装置:絶縁体成膜用	サンヨー電子 “SVC-700LRF”

微細加工プラットフォーム支援提供装置 C 群

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
FC-09	高精細電子線リソグラフィ装置	エリオニクス “ELS-7700T”
FC-10	電子ビームリソグラフィ装置	JEOL “JSM6500F with Beam Draw”
FC-11	集束イオンビーム装置	日立ハイテクサイエンス “SMI2050”
FC-12	リアクティブイオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NOU”
FC-13	ナノ薄膜形成システム(EB 蒸着アークプラズマ蒸着)	アルバック “UEP-2000 OT-H/C”
FC-14	マスクアライナー	ミカサ “MA-10”
FC-15	LED 描画システム	ピーエムティー “PLS-1010”
FC-16	イオンシャワーエッチング装置	エリオニクス “EIS-200ER”
FC-17	ナノインプリント装置	Obducat “Eitre 3”

分子・物質合成プラットフォーム支援提供装置

装置番号	設備(設備群)名	メーカー・機種
S01	人工超格子薄膜形成システム(PLD)	誠南工業 “PLO-020R”
S02	有機薄膜形成装置	誠南工業 “VCH-020R”
S03	環境制御型走査型プローブ顕微鏡システム	日立ハイテクサイエンス “NanoNavi II/SPA-300HV”
S04	薄膜 X 線回折装置	リガク “Ultima IV”
S05	赤外・テラヘルツ時間分解分光装置	日邦プレジジョン “Pulse IRS 2000-os”
S06	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光 “6100FV MCT-600”
S07	ナノ粒子解析装置(ゼーターサイザー)	シスメックス “NANO-ZS”
S08	位相変調型分光エリプソメーター	堀場製作所 “UVISEL LT NIR-NNG”
S09	誘導結合型 RF プラズマ支援スパッタ装置 (ICP-RF スパッタ装置)	アルバック “MB02-5002”
S10	RF スパッタ装置	サンヨー電子 “SVC-700LRF”
S11	高温熱処理装置(セラミックス電气管状炉)	誠南工業 “ARF-30K”
S12	紫外可視分光光度計	日本分光 “V-550”
S13	反応性イオンエッチング装置	サムコ “RIE-10NR”
S14	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ “SU9000”
S15	走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクサイエンス “Nanonavi Real/E-sweep”
S16	二次イオン質量分析ナノデバイス加工システム	伯東 “IBE-KDC75-EPD-OU-TA”
S17	接触式膜厚測定器	BURUKER “DektakXT”

S18	イオン化ポテンシャル測定装置	分光計器 “BIP-KV202GD”
S19	レーザーラマン顕微鏡	ナノフォトン “RAMAN-touch”
S20	電流密度測定装置	分光計器 “BIP-KV302K”